

IF1322A, IN1322B**N-Channel Matched Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor**

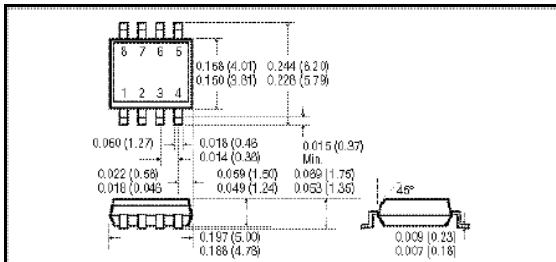
- Low Noise, High Gain Amplifier
- Differential Inputs

Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-20V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	480mW
Power Derating	3.8 mW/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$

At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature Static Electrical Characteristics		IF1322				Process NJ132L	
		Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS1}$ $V_{(BR)GSS2}$ $V_{(BR)GSS3}$	-20			V	$I_G = -25 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -3 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Fx	$\frac{V_{(BR)GSS1}}{V_{(BR)GSS2}}$	0.9		1.1			
Gate Reverse Current	I_{GSS}			-0.1	nA	$V_{GS} = -10 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-0.8		-1.5	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 1 \mu\text{A}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	I_{DSS}	8		25	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Forward Voltage	V_{GSF}	0.3		1.0	V	$V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \text{ mA}$ $V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \mu\text{A}$	
Dynamic Electrical Characteristics							
Common-Source Forward Transconductance	g_{fs}	0.01			mS	$V_{DS} = 5 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	1 kHz
Differential Gate Source Voltage-	A	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		30	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
	B	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		40	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage ¹	$\sim e_N$			4 2	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	100 hz 1 kHz
Equivalent Short Circuit Input Noise Current ¹	i_n			0.05	pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	1 kHz

Note 1: Guaranteed but not tested.



Dimensions in Inches (mm)

SOIC-8: IF1322
1-G1, 2-D1, 3-S1, 4-G2,
5-G2, 6-D2, 7-S2, 8-G1



715 N. Glenville Dr., Ste. 400
Richardson, TX 75081
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338
www.interfet.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.